

Applicant Name	Samsung Electronics Co., Ltd. (Applicant's code: 119981042713)
Address	416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Attorney Name	Chang-Hyun Yim et al.
Address	3rd Fl., 827-25, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea (Koryo International Patent & Law Office)
Application No.	10-2003-0008202

BEST AVAILABLE COPY

The cited reference 1 discloses

“a ferroelectric memory having a residual ferroelectric layer and a reaction preventing layer”

The cited reference 2 discloses

“a ferroelectric capacitor having an oxygen diffusion preventing layer”

Accordingly, the present invention is easily made by those skilled in the art upon the cited references 1 and 2. (Patent Act 29(2))

-Regarding claims 19-37,

The Examiner recognizes that the claimed invention is characterized in a method for fabricating a ferroelectric memory device comprising a step of forming a reaction buffer layer.

The cited reference 1 discloses

“a method for fabricating a ferroelectric memory comprising a step of forming a residual ferroelectric layer and a reaction preventing layer”

The cited reference 2 discloses

“a method for fabricating a ferroelectric capacitor comprising a step of forming an oxygen diffusion preventing layer”

Accordingly, the present invention is easily made by those skilled in the art upon the cited references 1 and 2.

Enclosure: 1. Korean Patent Publication No. 2002-97479 (Publication Date: 2002.12.31)

2. Korean Patent Publication No. 1998-40642 (Publication Date: 1998.08.17) End

December 27, 2004

Electricity Electron Device Examination Division, Intellectual Property Office

Examiner Kim, Geun-Mo

<<Information>>

If you have inquiry, call 042-481-5985

BEST AVAILABLE COPY

출력 일자: 2004/12/20

발송번호 : 9-5-2004-053340511

수신 : 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국

발송일자 : 2004.12.17

제특허법률사무소)

제출기일 : 2005.02.17

임창현 귀하

135-080

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 삼성전자주식회사 (출원인코드: 119981042713)
주소 경기도 수원시 영통구 매탄동 416
대리인 성명 임창현 외 1 명
주소 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국제특허법률사무소)
출원번호 10-2003-0008202
발명의 명칭 강유전체 메모리 소자 및 그 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-37항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통 상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29 조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 청구항 제1-18항의 반응완충막을 갖는 강유전체 메모리 소자는 인용발명1(한국공개특허공보 2002-97479호(2002.12.31))의 잔류 강유전체막, 반응방지막을 갖는 강유전체 메모리 및 인용발명2(한국공개특허공보 1998-40642호(1998.08.17))의 산소 확산 방지막을 갖는 강유전체 캐패시터 등에 서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)
2. 청구항 제19-37항의 반응완충막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 메모리 소자 제조방법은 인용 발명1의 잔류 강유전체막, 반응방지막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 메모리 제조방법 및 인용 발명2의 산소 확산 방지막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 캐패시터 제조방법 등에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

[첨부]

첨부 1 공개특허 제2002-97479호(2002.12.31) 1부.

첨부 2 공개특허 제1998-40642호(1998.08.17) 1부. 끝.

2004.12.17

특허청

전기전자심사국

응용소자심사담당관실

심사관 김근모



BEST AVAILABLE COPY

출력 일자: 2004/12/20

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5985 로 문의하시기 바랍니다.
서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터 ☎1544-8080으로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터

BEST AVAILABLE COPY